SnF₂添加による Sn(II)ペロブスカイトの合成

日大生産工(院) 〇日野 里海 日大生産工 山根 庸平 中釜 達朗 日大生産工(非常勤)山田 康治

1 緒論

近年,地球温暖化やエネルギー枯渇の問題 から自然エネルギーを用いた発電方法が重要 視されている.中でも太陽エネルギーを利用 した太陽電池の開発が盛んに行なわれており, シリコン系太陽電池だけでなく化合物系,有 機系など様々な種類の太陽電池がある.その 中で,最近高い変換効率を示す太陽電池とし て注目されているのがペロブスカイト型ハロ ゲン化物(Fig. 1)を用いたペロブスカイト型ハロ ゲン化物(Fig. 2).ペロブスカイト型ハロ ゲン化物はABX3 (A=カチオン,B=金属イ オン,X=ハロゲン化物イオン)と表現でき, 各サイトにおいて異種元素の固溶が可能であ る.そのため,固溶体の合成によってバンド ギャップ(*Eg*)を制御することが可能である.

光吸収材料として多く報告されているペロ ブスカイト化合物は CH₃NH₃PbI₃(以下 MAPbI₃)や CH(NH₂)₂PbI₃である.これらの ペロブスカイト化合物を用いて作製した太陽 電池では 20%を超える変換効率が報告され ている¹⁾.しかし,Pbの毒性による環境負荷 が問題点として残っている.そこで,B = Sn²⁺ とした Sn(II)ペロブスカイト(ASnX₃)での代用 が検討されている.ASnX₃を用いる際に問題 となるのは Sn(IV)の混在である.Sn(II)は大気 中で Sn(IV)へ酸化しやすく,Sn(IV)が結晶中 に混在することで半導体的な特性が失われ, 金属的な伝導性を示す.したがって,高純度 な Sn(II)ペロブスカイト化合物の合成及び薄 膜作製方法が求められている.

我々はペロブスカイト結晶中に取り込まれた Sn(IV)を除去する手法として SnF₂の添加²⁾に着目した.本報告では Sn(IV)化合物である(CH₃NH₃)₂SnBr₆(以下 MA₂SnBr₆)に SnF₂を添加し、その反応を追跡した.



Fig. 2 Structure of perovskite solar cells.

- 2 実験操作
- 2-1 MA₂SnBr₆の合成及び構造解析

金属 Sn に HBr 溶液を過剰量加え, Sn²⁺水 溶液を調製した. Sn²⁺水溶液を大気中で数日 間放置し, Sn⁴⁺水溶液を調製した. この水溶 液に CH₃NH₂ 溶液を加え, 大気中に放置させ ることで MA₂SnBr₆の結晶を析出させた. 得 られた結晶の X 線回折測定(以下 XRD 測定) を行い, Rietveld 解析より構造解析を行った.

2-2 還元剤 SnF2の添加効果

MA₂SnBr₆ + 2SnF₂ → 2MASnBr₃ + SnF₄ (1)
(1)式を想定して MA₂SnBr₆: SnF₂ = 1:2の
量論比で混合し、その後ガラス管に封管し
150 °C で5日間焼成した.なお、混合及び封管は窒素雰囲気下で行った.

得られた試料の XRD 測定,¹¹⁹Sn NMR 測定 を行い,構造及び Sn(II)と Sn(IV)の存在状態 について調査した. さらに物性評価として光 学特性を検討するために拡散反射スペクトル 測定を行った.

Synthesis of Sn(II) perovskite compounds by adding SnF₂ Satomi HINO, Yohei YAMANE, Taturou NAKAGAMA and Koji YAMADA

- 3 結果及び考察
- 3-1 MA₂SnBr₆の合成及び構造解析 合成により得られた黄色い結晶の Rietveld 解析結果及び結晶構造を Fig. 3 に示した.



and crystal structure. Crystal system : Tetragonal (Hexagonal lattice) Space group : R -3 (#148), $R_p = 0.160$, $R_F = 0.058$, S = 1.59, Lattice parameters : a = b = 7.567(4) Å,

3-2 還元剤 SnF2の添加効果

c = 22.16(1) Å

焼成後の試料のXRDパターンをFig.4に示 した.Fig.4よりMASnBr₃のピーク位置と一 致したことからSnF₂の添加によりMA₂SnBr₆ からMASnBr₃が合成されたことが確認され た.

次に、¹¹⁹Sn NMR の結果を Fig. 5 に示した. 化学シフトの基準には(CH₃)₄Sn を用いた. Fig. 5 (a)に示した MA₂SnBr₆ と SnF₂ を混合し た試料では-280 ppm, -680 ppm, -2000 ppm にそれぞれ MASn^{II}B₃, Sn^{II}F₂, MA₂Sn^{IV}Br₆に 帰属できるピークが見られた. 一方,加熱後 (Fig.5 (b)) では Sn^{II}F₂及び MA₂Sn^{IV}Br₆の Sn(IV)のピークが消え, MASn^{II}Br₃のピーク強 度が強くなったことから(1)式の反応が起こ っていると考えられる.



Fig. 4 XRD patterns of MA₂SnBr₆ + 2SnF₂.



(a) $MA_2SnBr_6 + 2SnF_2$ before heating at 298 K.

measured at 390 K and (c) 298 K.

(b) $MA_2SnBr_6 + 2SnF_2$ after heating at 430 K

さらに、物性として光学特性を評価した. 拡散反射スペクトル測定の結果(Fig. 6)より算 出した E_g は 2.1 eV であり、SnBr₂ と MABr の 固相反応より合成した場合 (E_g = 2.1 eV) と 同様の結果が得られた.



Fig. 6 Diffuse reflectance spectra. (a) Synthesis by solid method and (b) adding SnF₂.

本結果より MA₂SnBr₆に還元剤として SnF₂ を添加することで MASnBr₃ が合成された.ま た, SnF₂の添加の有無に関らず光学特性の点 においては差異は無かった.したがって、ペ ロブスカイト太陽電池の光吸収材料への応用 に向けた高純度な薄膜作製法において SnF₂ の添加は有用であると期待される.

4 参考文献

T. Miyasaka, *Chem. Lett.* 2015, 44, 720–729.
M. H. Kumar, S. Dharani, W. L. Leong, P. P. Boix, R. R. Prabhakar, T. Baikie, C. Shi, H. Ding, R. Ramesh, M. Asta, M. Graetzel, S. G. Mhaisalkar, N. Mathews, *Adv. Mater.*, 2014, 26, 7122-7127.